

Уменьшить формируемое напряжение до 50 Вольт

Напряжение 100...310В, поддерживается за счет ОС РИМ-контроллера <u>Umax=310B, Imin = Pmax/Umax=12/310=38,7MA</u> Так как **Pmax=12**Bm, **Umin=100**B, **Imax = Pmax/Umin=12/110=0,11**A

Период = 9.6 мкс Мертвое время = 1.6мкс (для конденсатора 4,7 нФ) Частота генератора = 1,72/RtCt = 1.72/(2200nФ*7,5кОм)=104кГц Т.к. тах частота генератора = 50%, то реальная частота работы будет 52кГу

Максимальный рабочий цикл 93,2%. Максимальное время открытия 8,9 мкс

> № докум. Подп.

CKT5.**411126.001** 33

Лист 3

Копировал

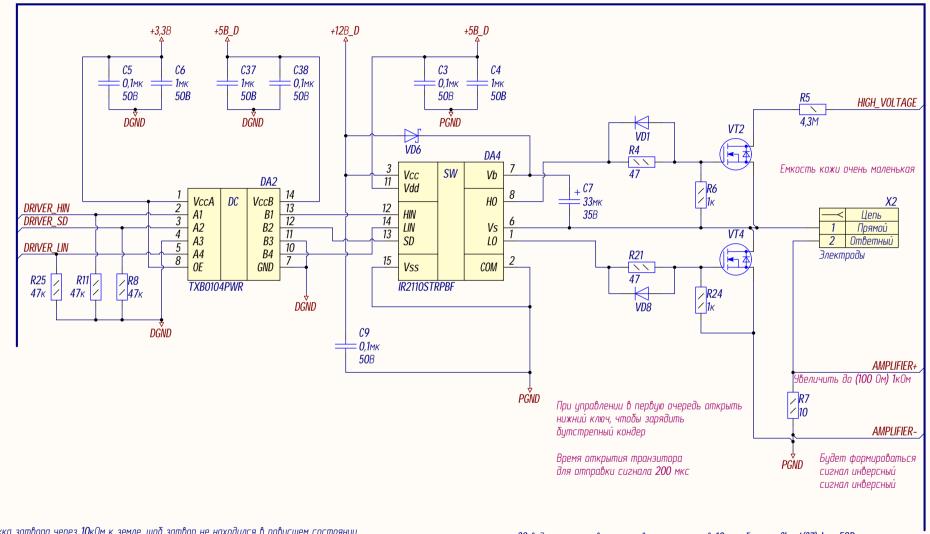
Формат АЗ

Igate=Ugs/Rg=12B/470m=0,255A

t open=Ciss*Ugs/Igate=1018pF*12V/0.255A=48нс RiseTime транзистора 23нс

Для человека безопасный ток (без вреда и воздействия): 50мкА - переменный, 100мкА - постоянный Для ограничения тока 50мкА резистор=Umax/I=310/50мкA=6,2МОм Рассеиваемая машнасть P=12R=50мкA*50мкA*6.2M0м=0.016Вт

Задаем сами Частоту коммутирования до 150Гц TurnOnRiseTime драйвера 35нс



Подтяжка затвора через 10кОм к земле, шоб затвор не находился в повисшем состоянии Частота генерации импульсов 100Гц= период ШИМ-10мс

Постоянная RC-затвор-исток = 47*1018pF=48нс, до 95% заряжается за 144нс Она не превышает период шим, значит все Гут!

C8 в даташите совет поставить не менее в 10 раз больше Cboot(C7) low ESR <u>Здесь пишут, что бустер дб 22-40мкФ (ЗЗоптимально)</u> https://microcontrollerslab.com/use-mosfet-driver-1r2110/

<u>Если бустер-электролитич, то параллельно нужен керамич(100н</u>Ф). Если танталовый-керамич не нижен

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СКТБ.411126.001 ЭЗ

Лист

